N		Datenblatt / Data sheet	infineon
Netz-Gleichrichterdiode **Rectifier Diode**		D850N	

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Höchstzulässige Werte / maximum rated values

Periodische Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltages	T_{vj} = -25°C... $T_{vj\,max}$	V_{RRM}	2800 3600 3200 4000	V V 1)
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert maximum RMS on-state current		I_{FRMSM}	1790	A
Dauergrenzstrom average on-state current	T_C = 100 °C	I_{FAVM}	850	A
Dauergrenzstrom average on-state current Durchlaßstrom-Effektivwert RMS on-state current	T_C = 55 °C, θ = 180°sin, t_P = 10 ms	I_{FAVM} I_{FRMS}	1210 1900	A A
Stoßstrom-Grenzwert surge current	T_{vj} =25 °C, t_P = 10 ms T_{vj} = $T_{vj\,max}$ t_P = 10 ms	I_{FSM}	15400 12800	A A
Grenzlastintegral I²t-value	T_{vj} = 25 °C, t_P = 10 ms T_{vj} = $T_{vj\,max}$, t_P = 10 ms	I²t	1186 819	10^3A^2s 10^3A^2s

Charakteristische Werte / Characteristic values

Durchlaßspannung on-state voltage	T_{vj} = $T_{vj\,max}$, i_F = 3,5 kA T_{vj} = $T_{vj\,max}$, i_F = 850 A	v_F	max. 2,62 max. 1,28	V V
Schleusenspannung threshold voltage	T_{vj} = $T_{vj\,max}$	$V_{(TO)}$	0,84	V
Ersatzwiderstand slope resistance	T_{vj} = $T_{vj\,max}$	r_T	0,485	mΩ
Durchlaßkennlinie 200 A ≤ i_F ≤ 4000 A on-state characteristic $v_F = A + B \cdot i_F + C \cdot \ln(i_F + 1) + D \cdot \sqrt{i_F}$	T_{vj} = $T_{vj\,max}$	A= B= C= D=	1,127E-01 5,455E-04 1,541E-01 -1,097E-02	
Sperrstrom reverse current	T_{vj} = $T_{vj\,max}$, v_R = V_{RRM}	i_R	max. 50	mA

Thermische Eigenschaften / Thermal properties

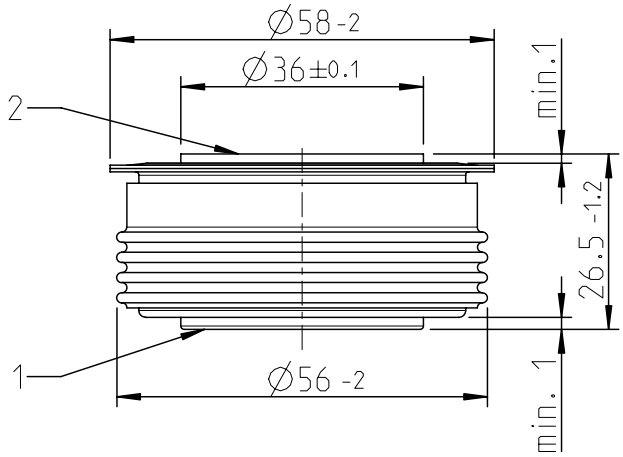
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	<u>Kühlfläche / cooling surface</u> beidseitig / two-sided, θ = 180°sin beidseitig / two-sided, DC Anode / anode, θ = 180°sin Anode / anode, DC Kathode / cathode, θ = 180°sin Kathode / cathode, DC	R_{thJC}	 max. 0,038 max. 0,035 max. 0,064 max. 0,061 max. 0,085 max. 0,082	 °C/W °C/W °C/W °C/W °C/W °C/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	<u>Kühlfläche / cooling surface</u> beidseitig / two-sided einseitig / single-sided	R_{thCH}	 max. 0,005 max. 0,010	 °C/W °C/W
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		$T_{vj\,max}$	160	°C
Betriebstemperatur operating temperature		$T_{c\,op}$	-40...+160	°C
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}	-40...+160	°C

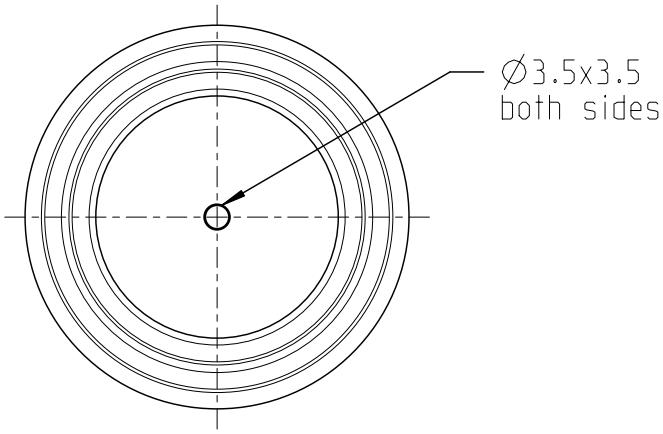
1) 4000V auf Anfrage / 4000V on request

prepared by:	H.Sandmann		date of publication:	2008-09-15
approved by:	M.Leifeld		revision:	3.0

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

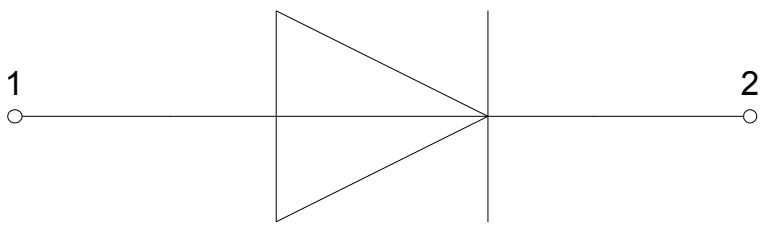
Gehäuse, siehe Anlage case, see annex			Seite 3 page 3	
Si-Element mit Druckkontakt Si-pellet with pressure contact				
Anpreßkraft clamping force		F	10...24	kN
Gewicht weight		G	typ. 285	g
Kriechstrecke creepage distance			25	mm
Schwingfestigkeit vibration resistance	f = 50 Hz		50	m/s²





strike distance: 20mm
creepage distance: 25mm

overall height based
on contact pressure



1: Anode/
Anode

2: Kathode/
Cathode

Netz-Gleichrichterdiode
Rectifier Diode

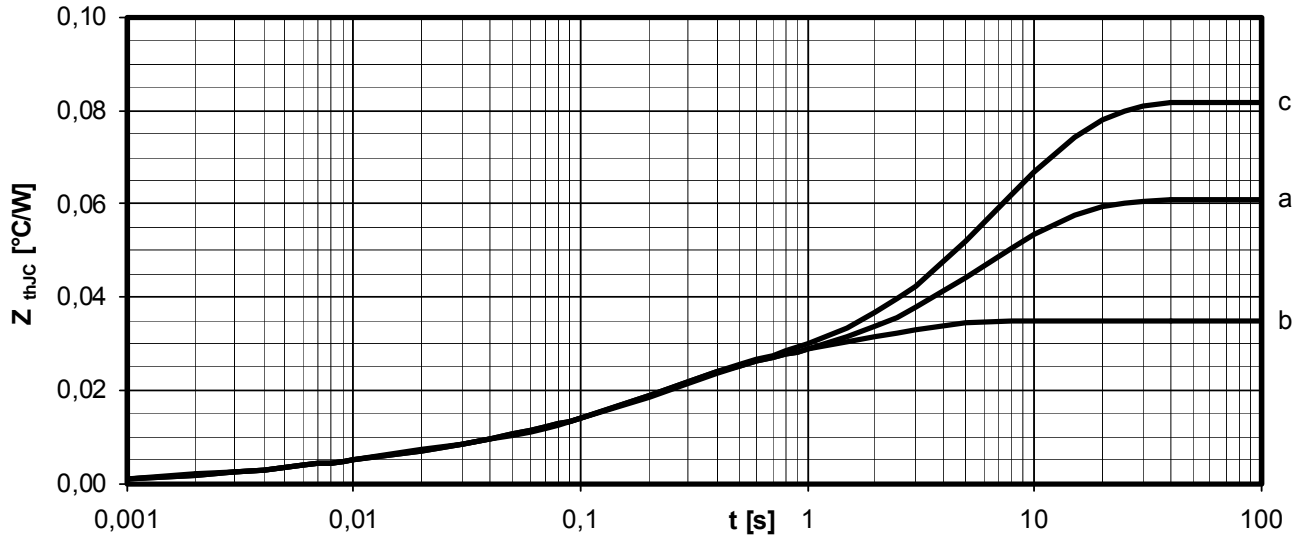
D850N

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJC} für DC
Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC} for DC

Kühlung / Cooling	Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
beidseitig two-sided	R_{thn} [°C/W]	0,00123	0,00397	0,0041	0,0153	0,0104	-	-
	τ_n [s]	0,00152	0,00932	0,0708	0,2510	1,7900	-	-
anodenseitig anode-sided	R_{thn} [°C/W]	0,00134	0,00466	0,0174	0,0376	-	-	-
	τ_n [s]	0,00159	0,01130	0,1770	6,2500	-	-	-
kathodenseitig cathode-sided	R_{thn} [°C/W]	0,00133	0,00457	0,0165	0,0596	-	-	-
	τ_n [s]	0,00159	0,01110	0,1690	7,3100	-	-	-

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn}\left(1 - e^{\frac{-t}{\tau_n}}\right)$$



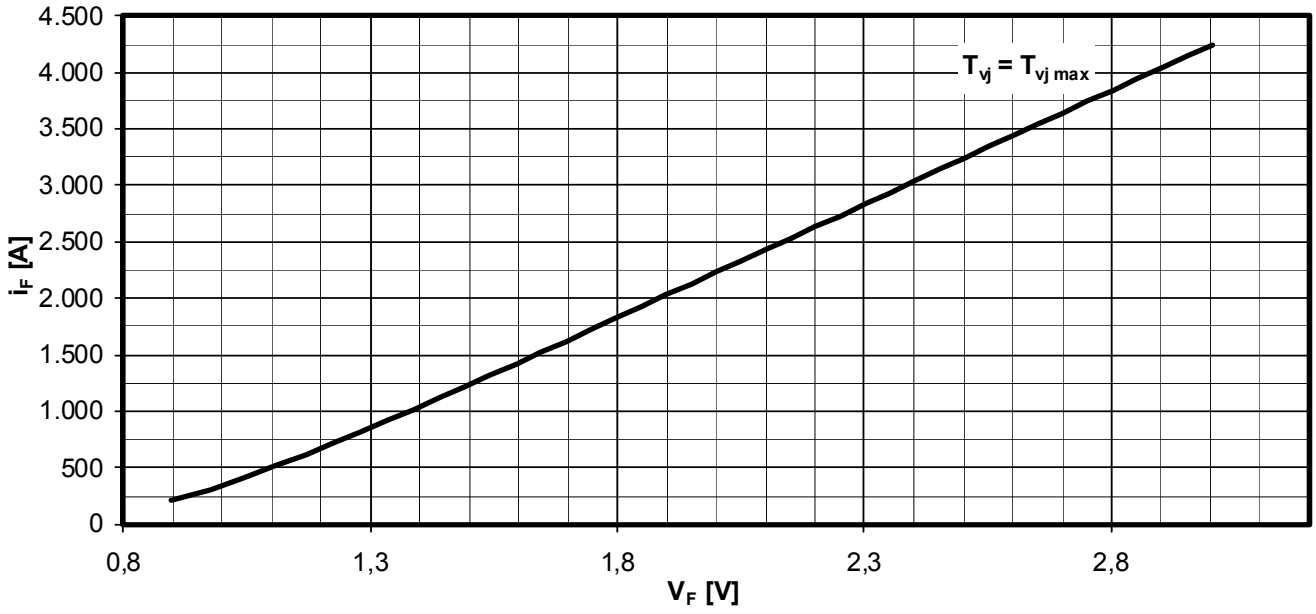
Transienter innerer Wärmewiderstand für DC / Transient thermal impedance for DC
$Z_{thJC} = f(t)$

a - Anodenseitige Kühlung / Anode-sided cooling
b - Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling
c - Kathodenseitige Kühlung / Cathode-sided cooling

Erhöhung des $Z_{th\ DC}$ bei sinus- und rechteckförmigen Strömen für unterschiedliche Stromflusswinkel Θ
Rise of $Z_{th\ DC}$ for sinewave and rectangular current for different current conduction angles Θ
$\Delta Z_{th\ \Theta\ rec}$ / $\Delta Z_{th\ \Theta\ sin}$

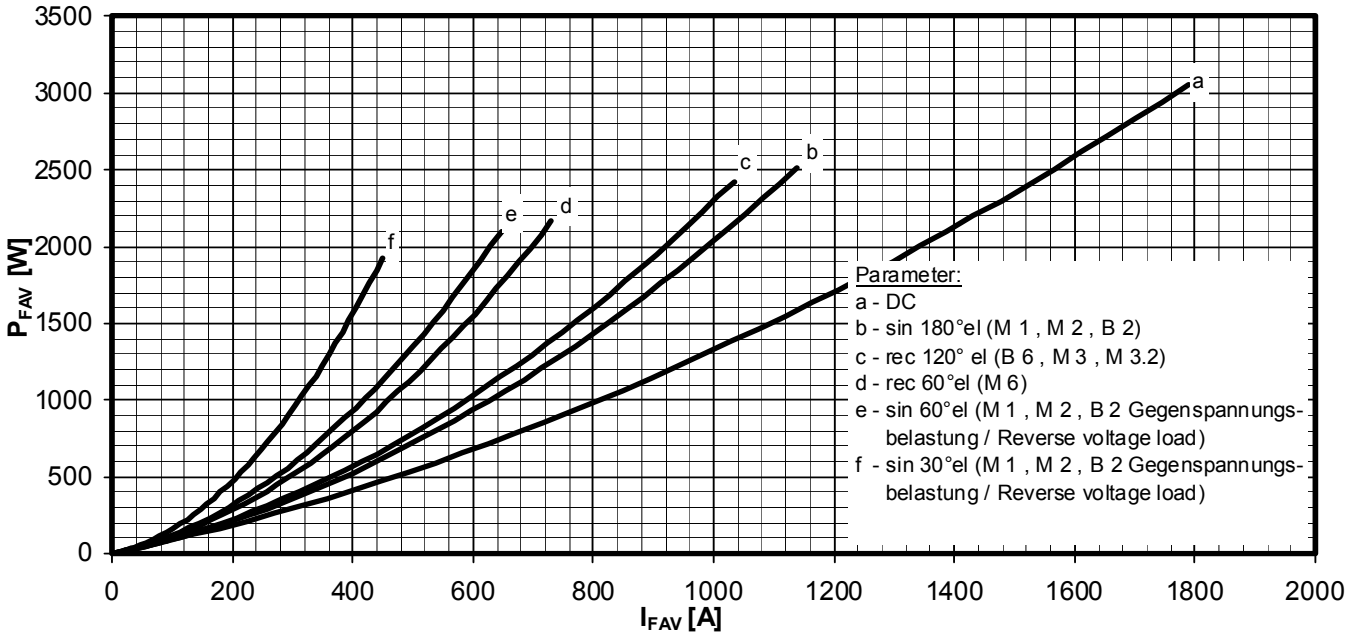
Kühlung / Cooling		Θ = 180°	Θ = 120°	Θ = 90°	Θ = 60°	Θ = 30°
beidseitig two-sided	$\Delta Z_{th\ \Theta\ rec}$ [°C/W]	0,00380	0,00617	0,00795	0,01053	0,01464
	$\Delta Z_{th\ \Theta\ sin}$ [°C/W]	0,00272	0,00384	0,00534	0,00783	0,01249
anodenseitig anode-sided	$\Delta Z_{th\ \Theta\ rec}$ [°C/W]	0,00378	0,00614	0,00795	0,01055	0,01467
	$\Delta Z_{th\ \Theta\ sin}$ [°C/W]	0,00271	0,00382	0,00533	0,00783	0,01253
kathodenseitig cathode-sided	$\Delta Z_{th\ \Theta\ rec}$ [°C/W]	0,00378	0,00611	0,00793	0,01052	0,01462
	$\Delta Z_{th\ \Theta\ sin}$ [°C/W]	0,00271	0,00381	0,00532	0,00781	0,01250

$$Z_{th\ \Theta\ rec} = Z_{th\ DC} + \Delta Z_{th\ \Theta\ rec}$$
$$Z_{th\ \Theta\ sin} = Z_{th\ DC} + \Delta Z_{th\ \Theta\ sin}$$



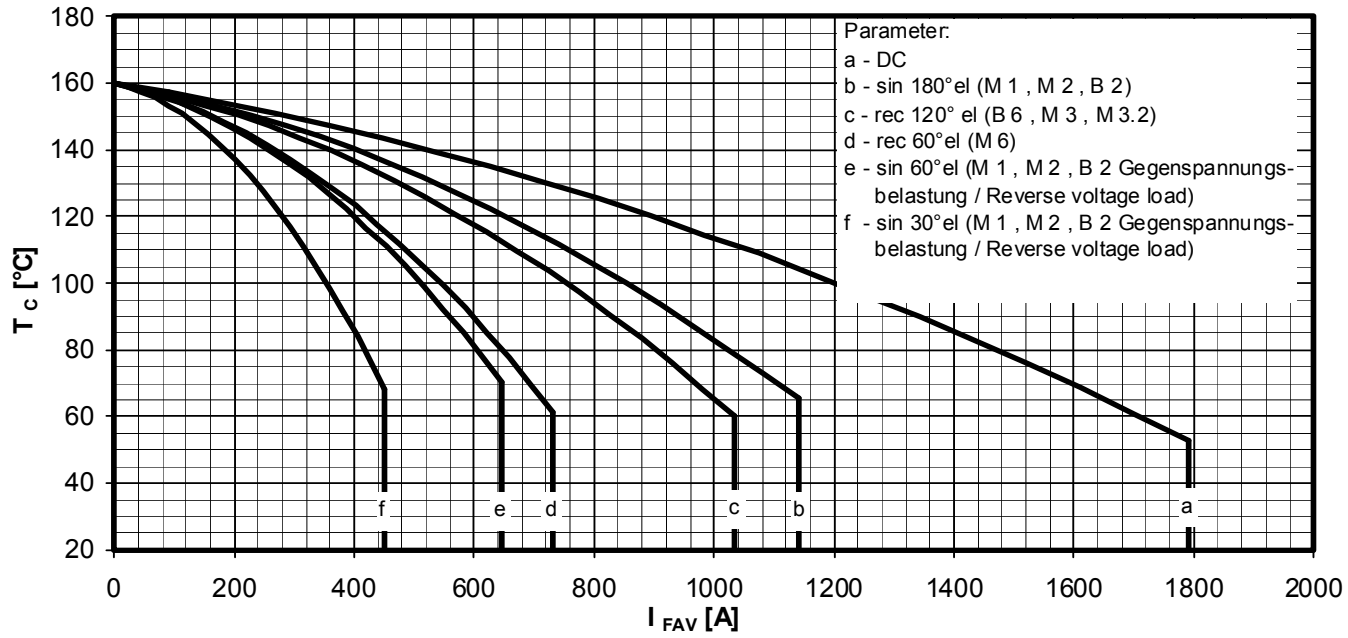
Grenzdurchlasskennlinie / Limiting on-state characteristic $i_F = f(v_F)$

$T_{vj} = T_{vj\ max}$



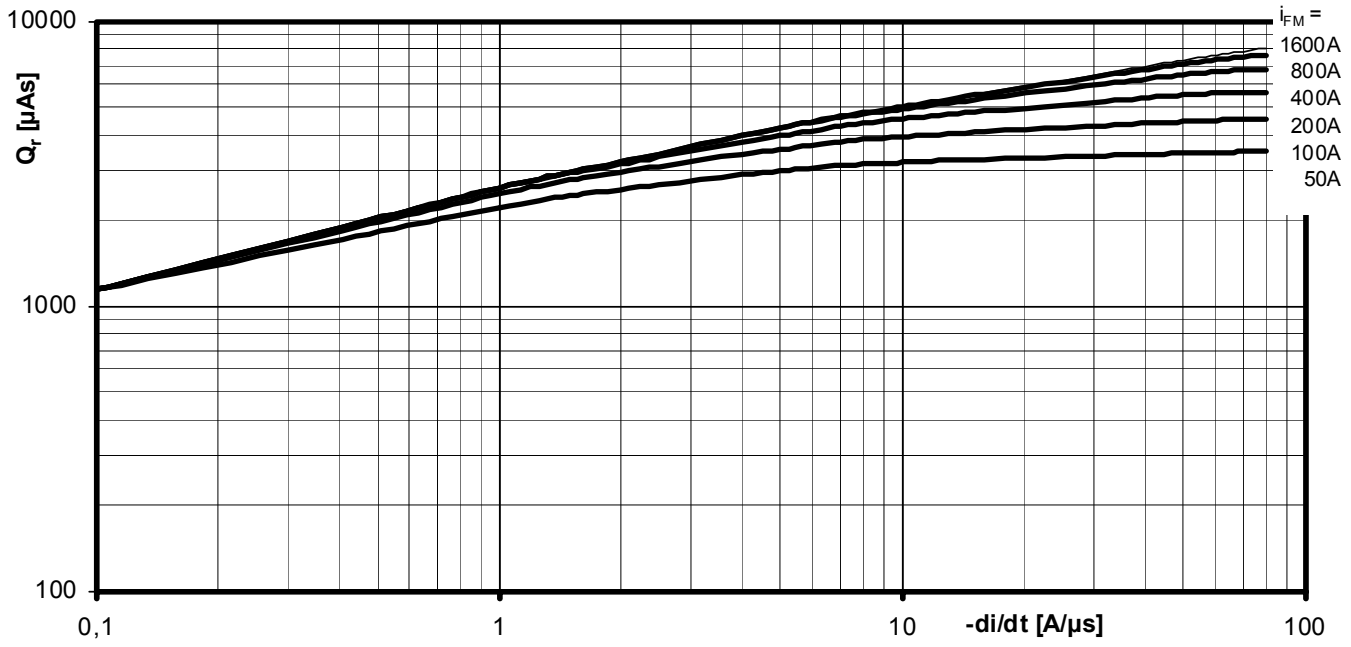
Durchlassverlustleistung / On-state power loss $P_{FAV} = f(I_{FAV})$

Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling

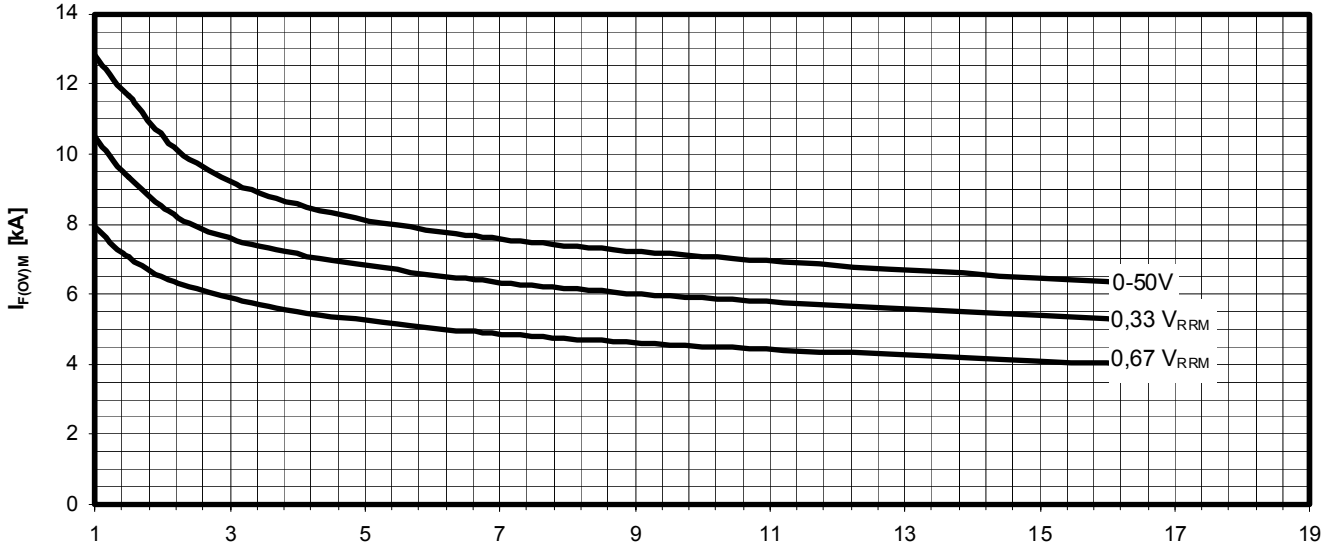


Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature $T_C = f(I_{FAV})$

Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling



Sperrverzögerungsladung / Recovered charge
Q_r =f(-di/dt)
T_{vj}= T_{vjmax} , $v_R \leq 0{,}5\ V_{RRM}$, v_{RM} = 0,8 V_{RRM}
RC-Glied / RC-Network: R = 3,9Ω, C = 1µF



Anzahl der Pulse bei 50Hz Sinus Halbwellen
Number of pulses of 50Hz sinusoidal half waves

Typische Abhängigkeit des Grenzstromes $I_{F(OV)M}$ von der Anzahl für eine Folge von Sinus Halbwellen bei 50Hz. Parameter: Rückwärtsspannung V_{RM}
Typical dependency of maximum overload on-state current $I_{F(OV)M}$ as a number of a sequence of sinusoidal half waves at 50Hz. Parameter: peak reverse voltage V_{RM}
$I_{F(OV)M}$ = f (pulses, V_{RM}) ; T_{vj} = $T_{vj\ max}$

Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Geeignetheit dieses Produktes für die von Ihnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe www.infineon.com). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle
- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.infineon.com). For those that are specifically interested we may provide application notes.
Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or live endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend
- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9